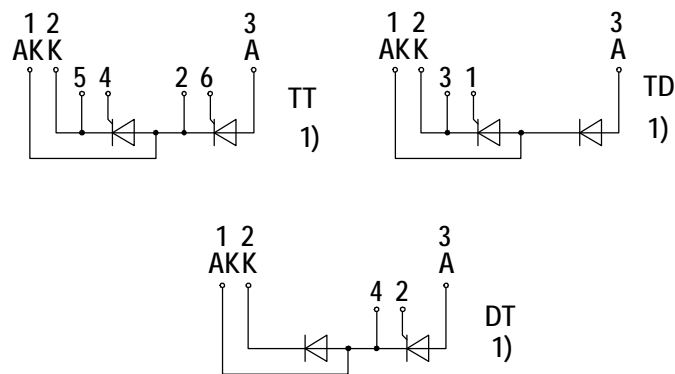
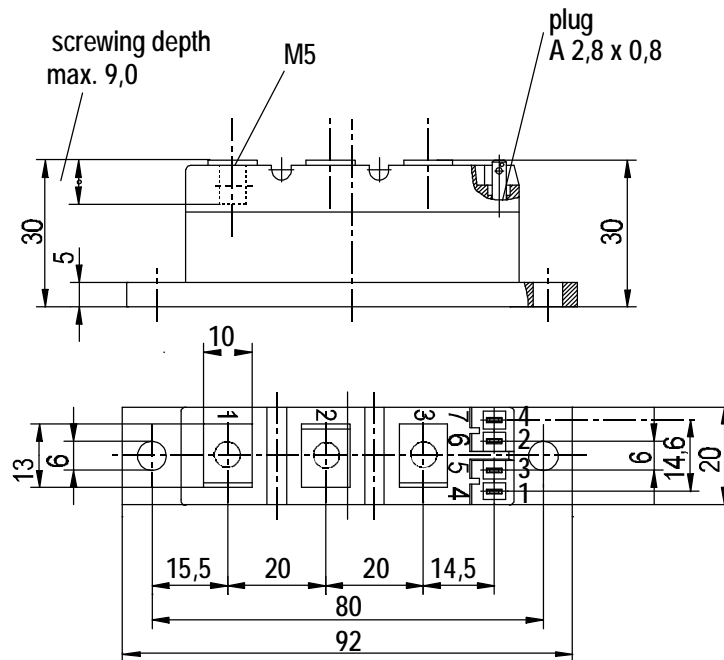


European Power-Semiconductor and Electronics Company

# Marketing Information

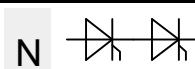
## TT 61 N



# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor  
Module

## TT 61 N 12...16



### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

#### Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	1200, 1400 1600	V V
Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$	$V_{\text{DSM}}$	1200, 1400 1600	V V
Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$	$V_{\text{RSM}}$	1300, 1500 1700	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current		$I_{\text{TRMSM}}$	120	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{C}} = 76^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{TAVM}}$	60 76	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10\text{ms}$	$I_{\text{TSM}}$	1550 1400	A A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10\text{ms}$	$I^2t$	12000 9800	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{\text{GM}} = 0,6\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$	150	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, v_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 6. Kennbuchstabe / 6th letter F	$(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$	1000	$\text{V}/\mu\text{s}$

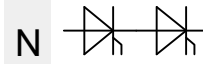
#### Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, i_{\text{T}} = 300\text{A}$	$v_{\text{T}}$	max. 1,9	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}$	$V_{(\text{TO})}$	0,8	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj \max}$	$r_{\text{T}}$	3,4	$\text{m}\Omega$
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}$	$I_{\text{GT}}$	max. 120	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}$	$V_{\text{GT}}$	max. 1,4	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj \max}, v_{\text{D}} = 6\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$I_{\text{GD}}$	max. 5,0 max. 2,5	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$V_{\text{GD}}$	max. 0,2	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{A}} = 5\Omega$	$I_{\text{H}}$	max. 200	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{GK}} \geq 10\Omega$ $i_{\text{GM}} = 0,6\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}, t_{\text{G}} = 20\mu\text{s}$	$I_{\text{L}}$	max. 620	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj \max}$ $v_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, v_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$	max. 20	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 0,6\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	$t_{\text{gd}}$	max. 3	$\mu\text{s}$

# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor  
Module

## TT 61 N 12...16



### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vi} = T_{vi\ max}$ , $i_{TM} = 400A$ $V_{RM} = 100V$ , $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dV_D/dt = 20V/\mu s$ , $-di_T/dt = 10A/\mu s$ 5. Kennbuchstabe / 5th letter O	$t_q$	typ. 120	$\mu s$
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50Hz$ , $t = 1min$ RMS, $f = 50Hz$ , $t = 1sec$	$V_{ISOL}$	2,5 3,0	kV kV

### Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innere Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per module, $\Theta = 180^\circ$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Modul / per module, DC pro Zweig / per arm, DC	$R_{thJC}$	max. 0,26 max. 0,52 max. 0,25 max. 0,50	$^\circ C/W$ $^\circ C/W$ $^\circ C/W$ $^\circ C/W$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module pro Zweig / per arm	$R_{thCK}$	max. 0,08 max. 0,16	$^\circ C/W$ $^\circ C/W$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vi\ max}$	125	$^\circ C$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\ op}$	- 40...+125	$^\circ C$
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stq}$	- 40...+130	$^\circ C$

### Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3 page 3	
Si-Elemente mit Druckkontakt Si-pellets with pressure contact				
Innere Isolation internal insulation			AIN	
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque	Toleranz / tolerance $\pm 15\%$	M1	4	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / tolerance +5% / -10%	M2	4	Nm
Gewicht weight		G	typ. 160	g
Kriechstrecke creepage distance			12,5	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50Hz$		50	$m/s^2$

Kühlkörper / heatsinks : KM11; KM14; KM17; KM33

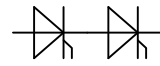
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. / This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor  
Module

## TT 61 N 12...16

N



Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  für DC

Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^{\circ}C / W]$	0,0218	0,0426	0,1886	0,2470			
$\tau_n [s]$	0,000945	0,0100	0,3100	1,7620			

Analytische Funktion: 
$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$